
	<h2>SIR422DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR422DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR422DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 43040 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR422DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	43040 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 40A (Tc) 5W (Ta), 34.7W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 34.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.6 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1785pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIR422DP-T1-GE3CT

SIR422DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIR422DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIR422DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIR422DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIR422DP-T1-E3 VISHAY SIR422DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR426DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR424DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR418DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR422DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR426DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR42-21C/TR8 EVERLIG EVERLIG 42-21</p>	 <p>SIR422DP VISHAY VISHAY QFN8</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIR406DP	↔ SIR406DP-T1-E3	⇒ SIR406DP-T1-GE3	D SIR406DP-T1-GE3	↔ SIR406DP-T1-GE3-S
⊣ SIR408DP-T1-GE3	⊛ SIR408DP-T1-GE3	D SiR410DP-T1-E3	⇒ SIR410DP-T1-GE3	↔ SIR410DP-T1-GE3
⊛ SiR412DP	⊣ SiR412DP-T1-E3	⊛ SIR412DP-T1-GE3	↔ SIR412DP-T1-GE3	↔ SIR414DP
D SIR414DP-T1-GE3	⊛ SIR414DP-T1-GE3	⊣ SIR416DP	⊛ SiR416DP-T1-E3	↔ SIR416DP-T1-GE3
⇒ SIR416DP-T1-GE3	↔ SiR418DP-T1-E3	⊛ SIR418DP-T1-GE3	⊣ SIR418DP-T1-GE3	↔ SiR422DP-T1-E3
↔ SIR422DP-T1-GE3	⇒ SIR424DP-T1-GE3	D SIR424DP-T1-GE3	⊛ SIR426DP-T1-GE3	⊣ SIR426DP-T1-GE3
⊛ SIR428DP	D SIR428DP-T1-E3	⇒ SIR428DP-T1-GE3	↔ SIR432DP-T1-GE3	↔ SIR432DP-T1-GE3
⊣ SiR436DP-T1-E3	⊛ SIR436DP-T1-GE3	↔ SIR436DP-T1-GE3	⇒ SiR438DP	↔ SIR438DP-T1-GE3
⊛ SIR438DP-T1-GE3	⊣ SIR440DP-T1-GE3	⊛ SIR440DP-T1-GE3	D SIR460DP	↔ SIR460DP-T1-E3
↔ SIR460DP-T1-GE3	⊛ SIR460DP-T1-GE3	⊣ SIR462DP	⊛ SIR462DP-T1-E3	↔ SIR462DP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

